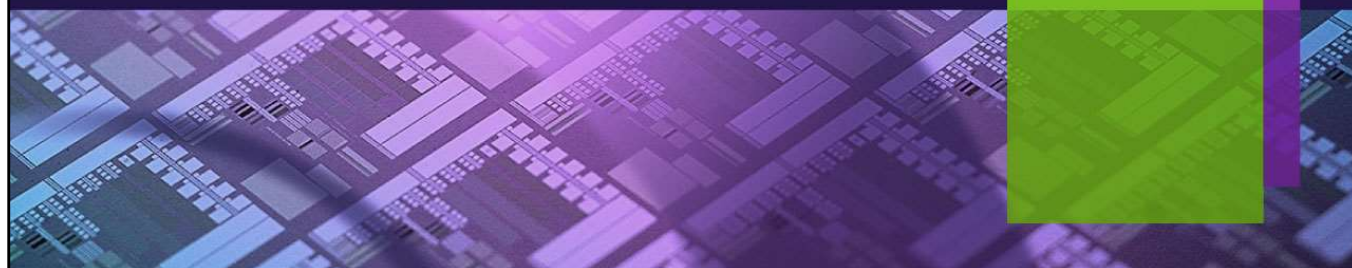


2025年3月期（2024年4月～2025年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2025年4月30日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

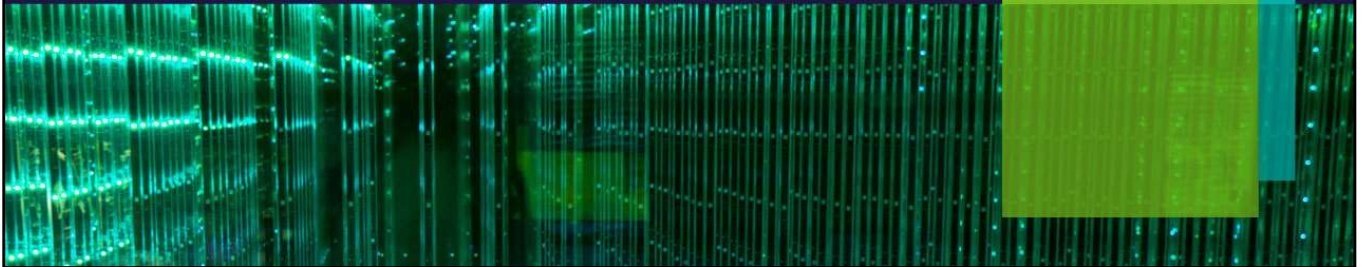
- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2025年3月期 連結決算の概要

2025年4月30日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



改めまして、川本でございます。

私から、2025年3月期、連結決算の概要 をご説明いたします。

損益状況

(億円)

	FY2024	FY2025	対前期 増減	(ご参考) 2025年2月6日発表の FY2025予想
売上高	18,305	24,315	+32.8%	24,000
売上総利益	8,302	11,462	+38.1%	11,290
売上総利益率	45.4%	47.1%	+1.7pts	47.0%
販管費	3,740	4,489	+20.0%	4,490
営業利益	4,562	6,973	+52.8%	6,800
営業利益率	24.9%	28.7%	+3.8pts	28.3%
税金等調整前当期純利益	4,734	7,061	+49.1%	6,910
親会社株主に帰属する当期純利益	3,639	5,441	+49.5%	5,260
1株当たり当期純利益 (円)	783.75	1,182.40	+50.9%	1,142.47
研究開発費	2,028	2,500	+23.2%	2,540
設備投資額	1,218	1,621	+33.1%	1,700
減価償却費	523	621	+18.7%	630

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

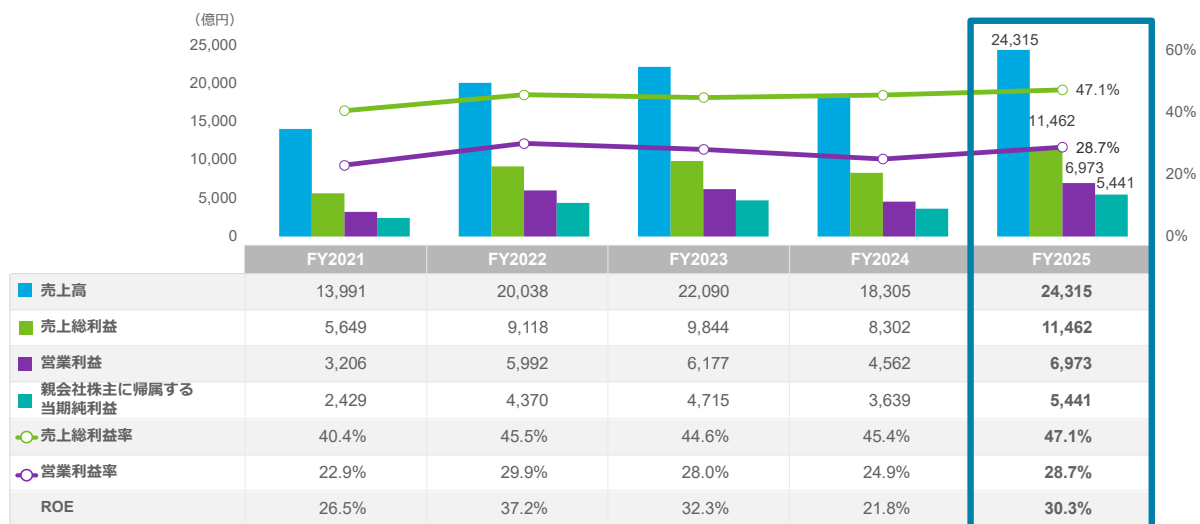
こちらは、2025年3月期の損益状況です。まず、ご案内しておりました業績予想を、売上高・利益・利益率すべてにおいて上回る結果となりましたのでご報告いたします。

それでは、青枠の部分を中心にご覧ください。

売上高は、先端・成熟世代ともに顧客の設備投資が活発に行われ、2兆4,315億円、前期比32.8%の増収となりました。売上総利益は、1兆1,462億円、初めて1兆円の大台を超えました。売上総利益率は高付加価値・高利益率の製品が貢献し、47.1%となりました。営業利益は、前期比52.8%増加の6,973億円となりました。営業利益率に関しましては、将来の成長に向けた積極的な研究開発投資を進める一方で、過去最高の売上総利益率を達成し、前期比3.8ポイント増加の28.7%となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比49.5%増加の5,441億円となりました。

研究開発費につきましては、前述しましたとおり成長投資を継続し、前期比23.2%増加の2,500億円となりました。設備投資額は1,621億円。主に、東京エレクトロン九州・東京エレクトロン宮城の開発棟など、各拠点の建設プロジェクトや、評価用機械装置の取得によるものです。減価償却費は、前期比18.7%増加の621億円となりました。

損益状況の推移（FY2021～FY2025）



FY2022の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しています。

売上高・売上総利益・営業利益・当期純利益すべてにおいて、
過去最高の業績を達成

Investor Relations / April 30, 2025

TEL

5

こちらは、損益状況の推移をまとめております。

2025年3月期は、売上高・売上総利益・営業利益・当期純利益すべてにおいて、過去最高の業績を達成いたしました。

また、売上総利益率・当期利益率も過去最高となりました。

ROEにつきましては、30%の大台を超え、30.3%となりました。

損益状況（四半期）

（億円）

	FY2024	FY2025				vs. FY2025 Q3	vs. FY2024 Q4
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
売上高	5,472	5,550	5,665	6,545	6,554	+0.1%	+19.8%
売上総利益	2,561	2,640	2,599	3,117	3,105	-0.4%	+21.3%
売上総利益率	46.8%	47.6%	45.9%	47.6%	47.4%	-0.2pts	+0.6pts
販管費	1,108	982	1,117	1,121	1,267	+13.1%	+14.3%
営業利益	1,452	1,657	1,481	1,996	1,837	-7.9%	+26.6%
営業利益率	26.5%	29.9%	26.2%	30.5%	28.0%	-2.5pts	+1.5pts
税金等調整前当期純利益	1,578	1,672	1,536	2,001	1,851	-7.5%	+17.3%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,249	1,261	1,177	1,572	1,429	-9.1%	+14.4%
研究開発費	584	534	620	618	727	+17.7%	+24.5%
設備投資額	329	239	533	502	346	-31.1%	+4.9%
減価償却費	153	132	145	160	183	+14.4%	+19.7%

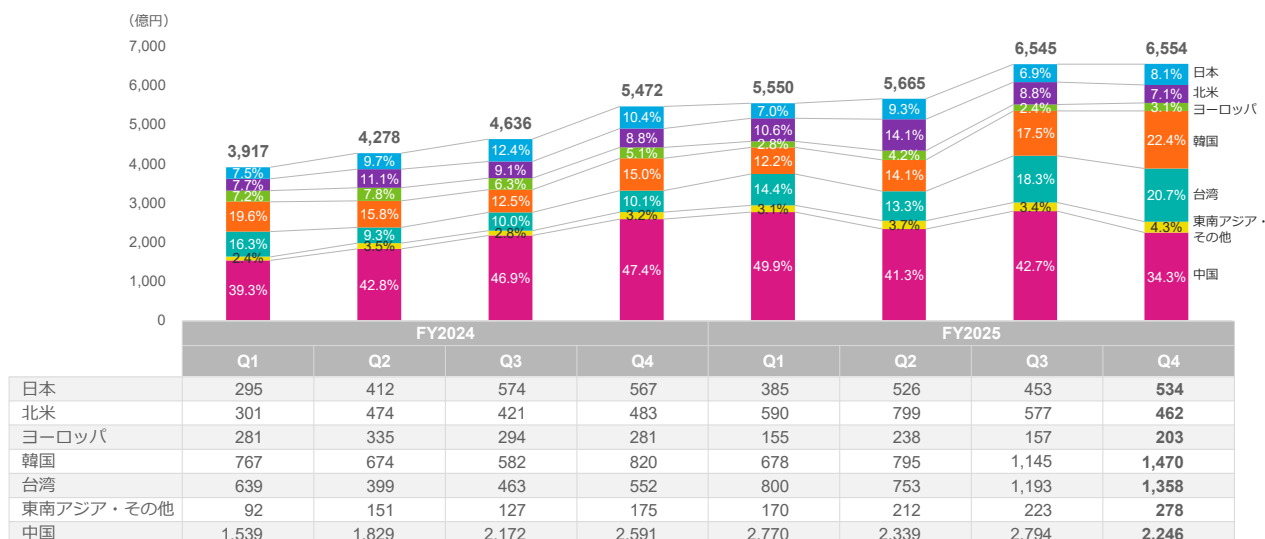
1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

こちらは、四半期ごとの「損益状況」です。青枠の部分を中心にご覧ください。

第4四半期の売上高は、第3四半期を若干上回り、6,554億円となりました。売上総利益は、前四半期比0.4%減少の3,105億円。売上総利益率は、前四半期比0.2ポイント減少の47.4%となりました。営業利益は、研究開発費を主とした販管費の増加もあり、前四半期比7.9%減少の1,837億円。営業利益率は、前四半期比2.5ポイント減少の28.0%となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前四半期比9.1%減少の1,429億円となりました。

この第4四半期の設備投資額は346億円でした。

地域別売上高構成比（FY2024 Q1～FY2025 Q4）



Investor Relations / April 30, 2025

TEL

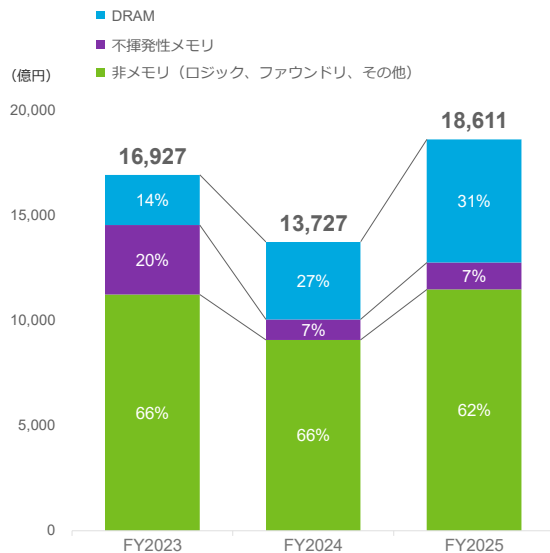
7

こちらは、「地域別売上高」です。

第4四半期の構成比につきましては、韓国で前四半期比4.9ポイント増加し22.4%、台湾で前四半期比2.4ポイント増加し20.7%となりました。

中国向けの売上高構成比につきましては、40%超の水準が続いておりましたが、第3四半期への出荷前倒しや、新興のお客様の設備投資が一服したこともあり、第4四半期の比率は34.3%と、前四半期比8.4ポイント減少いたしました。

SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比



- DRAM：HBM向けなど先端投資が売上・構成比の増加に大きく貢献
- 不揮発性メモリ：構成比は同水準も、顧客の投資は徐々に回復基調に転じ、売上は増加傾向
- 非メモリ：成熟向けの需要に加え、最先端設備投資が活発に行われ、売上は大きく増加

1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置
2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません。

Investor Relations / April 30, 2025

TEL

8

こちらは、SPE新規装置の売上をアプリケーション別に示したものです。

2025年3月期は、下から非メモリ62%、不揮発性メモリ7%、DRAM31%となりました。

DRAMにおいてはHBM向けなど、旺盛な先端投資が売上高・構成比の増加に貢献いたしました。

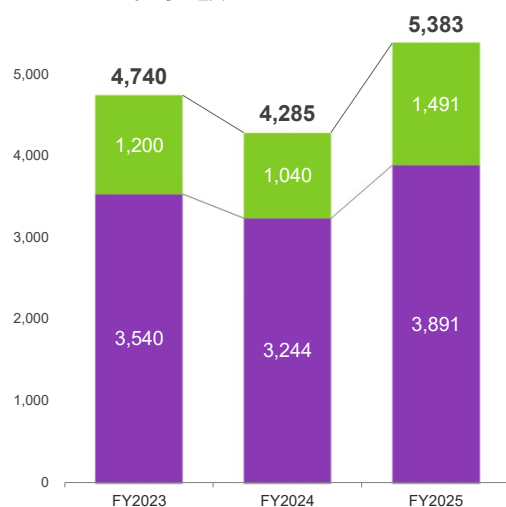
不揮発性メモリは、構成比としては前期と同水準でしたが、顧客の投資は徐々に回復基調に転じております。売上高は増加傾向となりました。

非メモリは、成熟向けの需要に加え、最先端設備投資が活発に行われ、前期に比べ、売上高は大きく増加いたしました。

フィールドソリューション売上

(億円)
6,000

■ 中古装置・改造
■ パーツ・サービス



- FY2025の売上は、前期比25.6%増の5,383億円
- 顧客の工場稼働率の回復に伴い、パーツ・サービス、中古装置・改造ともに好調

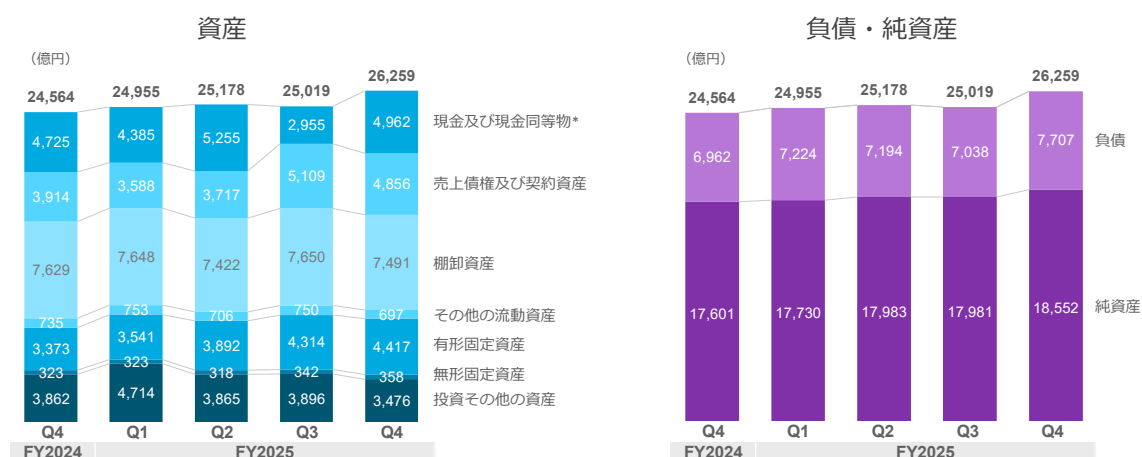
Investor Relations / April 30, 2025

TEL

9

続きまして、フィールドソリューション売上になります。2025年3月期の売上高は、前期比 25.6%増加の 5,383億円となりました。顧客の工場稼働率の回復に伴い、パーツ・サービス、中古改造ともに売上高は好調に推移いたしました。

貸借対照表（四半期）



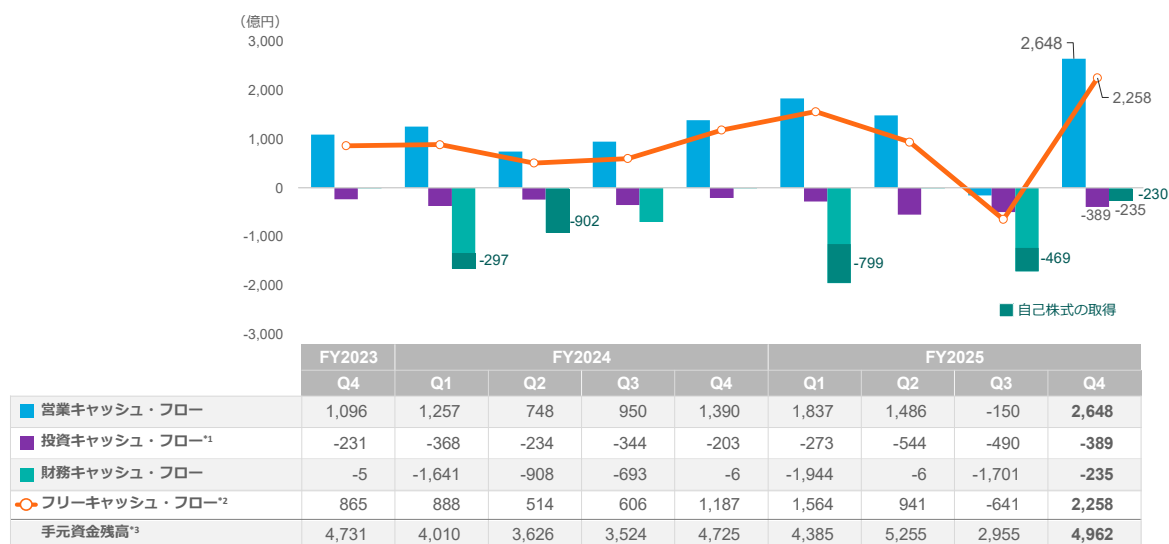
*現金及び現金同等物：現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

続きまして、「貸借対照表」をご説明いたします。

資産合計は、2兆6,259億円となりました。現金同等物は、4,962億円。前四半期から2,007億円増加いたしました。売上債権及び契約資産は、前四半期比252億円減少の4,856億円。棚卸資産は、前四半期比159億円減少の7,491億円。投資その他の資産は、株式の時価減少等もあり、前四半期から420億円減少し、3,476億円となりました。

続いて、右側の負債・純資産でございますが、負債は、主に未払法人税等の計上により、前四半期から669億円増加の7,707億円となりました。純資産は、前四半期比570億円増加の1兆8,552億円となりました。なお、自己資本比率は70.1%となりました。

キャッシュ・フロー（四半期）



^{*1} 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

^{*2} フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

^{*3} 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

Investor Relations / April 30, 2025

TEL

11

続きまして、「キャッシュ・フロー」をご説明いたします。

この四半期における営業キャッシュフロー獲得は、2,648億円でした。

投資キャッシュフローの支出は、主に、評価用機械装置等の固定資産の取得により、389億円。

財務キャッシュフローの支出は、235億円。こちらは、主に自己株式の取得によるものです。

この結果フリーキャッシュフローは、2,258億円の収入となりました。

なお、フリーキャッシュフローは、四半期、また通期としても、過去最高額を記録することができました。

私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

事業環境および業績予想

2025年4月30日

代表取締役社長・CEO

河合 利樹



河合でございます。

「事業環境 および 業績予想」について、ご説明致します。

FY2025 事業ハイライト

- 売上高、利益とも、過去最高額を達成。売上総利益は初めて1兆円を上回る
 - 売上高成長率は+33%。特にDRAMは、HBM*1向けに幅広い装置群が採用され、+59%と大きく伸長
- マーケットシェア拡大。戦略製品の量産POR*2奪取が寄与
 - エッチング装置：DRAM Capacitor工程で大手顧客独占、NAND Channel工程（極低温 Etch）で新規獲得、Slit工程で拡販、ロジック・HBM向け先端パッケージ配線工程で採用
 - ウェーハボンダー：HBM向けテンポラリーボンダー/デボンダーの需要大幅増
 - プローバ：高シェアを誇る先端ロジック向け投資拡大の潮流を捉え、売上増大
- 新領域への参入により将来の売上貢献が期待される新製品をリリース
 - 枚葉プラズマCVD装置「Episode™ 1」、PVD装置「LEXIA™-EX」、ガスクラスタービーム装置「Acrevia™」、レーザー剥離装置「Ulucus™ LX」
- 約1,500億円の自己株式取得を完了

*1 HBM (High Bandwidth Memory) : 高帯域幅DRAM
*2 POR (Process of Record)

まず、「FY2025 通期の 事業ハイライト」について ご説明します。

FY2025は、AIサーバー向け 先端ロジックや HBM向け投資が大幅に増加したことに加え、中国の前倒し投資もあり、通期では、売上高 2兆4,315億円、売上総利益 1兆1,462億円、営業利益 6,973億円、当期純利益 5,441億円と、いずれも過去最高額となりました。微細化、高積層化、3次元実装など、技術革新を支える付加価値の高い製品の拡販により、売上総利益が初めて1兆円を超え、売上総利益率は47.1%となりました。売上高成長率は+33%。なかでも、DRAMは、HBM向けに幅広い装置群が採用され、前年比 59%増となりました。

マーケットシェアも大きく拡大しました。なかでも、エッチング装置は、DRAMで最も難しいCapacitorエッチング工程において、大手顧客の量産PORを独占できたこと、NAND Channelエッチング工程において、極低温エッチングが1社で量産採用され、売上に寄与したこと、また、新規でPORを獲得した NAND Slitエッチング工程が拡販に繋がったこと、さらに、ロジックやHBM向け 先端パッケージの配線工程でエッチング装置の需要が拡大したことを受けて、昨年比 約6%ポイントのシェア拡大に成功しました。ウェーハボンダーは、HBM向け需要の拡大ウェーハプローバは、先端ロジック向け投資拡大の潮流をしっかりと捉えて売上を拡大し、それぞれ大きくシェアを伸ばしました。特に、ボンダーの売上は約300億円と、この2年で3倍になりました。

また、当社の将来の売上・利益をさらに拡大する、新領域への参入も、着実に進捗しました。枚葉プラズマCVD、PVDといった未参入領域への展開や、最先端リソグラフィーの効率化に貢献する ガスクラスタービーム装置、プロセス時の環境負荷を大幅に低減するレーザー剥離装置など、半導体技術革新に貢献する、ユニークな新製品を複数リリースしました。

また、FY2025は、総額で、約1,500億円の自己株式を取得しました。

事業環境（2025年4月時点でのWFE市場の見方）

■ CY2025：前年同等の\$110B程度と予想

- 車載やパワー半導体投資、中国新興メーカーの投資は一服
- AIサーバー向け需要に伴う最先端ロジックとHBMが投資を牽引

■ CY2026：二桁成長を期待

- 引き続きAIサーバー向け需要は旺盛。2nm量産投資が加速
- PCやスマホへのAI搭載比率の上昇に伴う半導体消費が増加

超高速・大容量・高信頼性・低消費電力の実現に向け、
スケーリングとヘテロジニアスインテグレーションの2軸で技術革新が進展。
GAA^{*1}・BSPDN^{*2}・HBMやテスト工程など、TELの事業機会は拡大

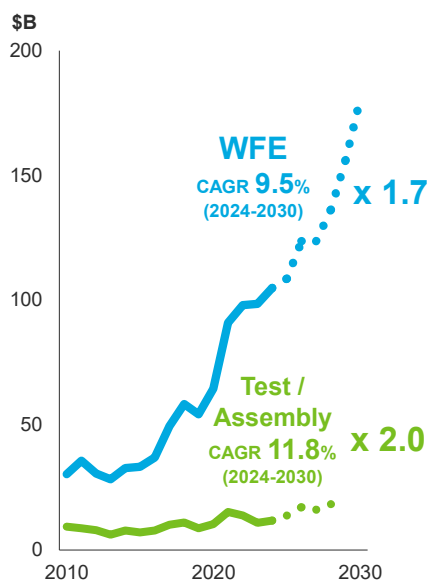
次に、「事業環境」について、ご説明します。

CY2025のWFE市場は、3か月前と変更なく、前年同等の110Bドル程度と予想しています。車載やパワー半導体、中国新興メーカーなどの成熟世代向け投資に一服感はありませんが、AI向け半導体の需要は引き続き拡大しているため、最先端ロジックやHBM向けの投資が期待でき、WFEは過去最高レベルが継続する見込みです。

CY2026も、AI関連向けの投資拡大がWFEを牽引します。AIサーバー向けGPUは、現行の4nm世代から、3nmが主力になり、搭載されるHBMも、現在の8層から12層、16層へ微細化を伴いながら増加します。加えて、PCやスマホなど、エッジ側へのAIの本格導入も開始され、2nmのロジックやDDR5の需要が見込まれます。これらにより、WFE市場は二桁成長が期待できます。

AI用途には、最先端の半導体技術が求められます。超高速、大容量、高信頼性、低消費電力の半導体デバイスの実現に向け、半導体の代名詞であるスケーリングと、新たな牽引役であるヘテロジニアスインテグレーションの2軸で技術革新が進展します。GAA、Backside PDN、次世代DRAM、NANDの高積層化やパッケージング工程などの技術進化に伴い、当社のビジネス機会はますます拡大していきます。

今後の成長を見据えた注力技術



Source : TechnoInsights (April 2025)
Investor Relations / April 30, 2025

Frontend		
Logic : GAA, BSPDN - EUV Coater/Developer - Gas Chemical Etch - Conductor Etch - PVD Metal Overburden - CFET/Inner Spacer - Plasma CVD for filling film - Double-sided scrubber - Backside/bevel cleaning - Pattern Shaping - Wafer Bonder - Laser Tool	DRAM: 2D & 3D DRAM - EUV Coater/Developer - Capacitor Mold Etch - Batch High-k Capacitor deposition - PVD Metal Hardmask - Supercritical Cleaning - Backside/bevel Cleaning - Wafer Bonder - Laser Tool	NAND: Beyond 4xx - Slit Etch - Channel Hole Etch (Plug) - Batch Mo deposition - Batch Cleaning WL Separation - Wafer Bonder - Laser Tool
Advanced Packaging		
Logic Packaging - Interposer, Polyimide & PR Coater/Developer - TDV Etch - Batch High-k Capacitor depo - Wafer Bonder - Laser Tool	HBM Packaging - Polyimide & PR Coater/Developer - Metal Etch for HBM - Aerosol Cleaning - Temporary Bonder/Debonder	Advanced Logic / Memory Test Prober

TEL

15

当社は最先端の技術開発をしている顧客とともに、10年先を見据えた、4世代分の開発を同時並行で進めていますが、次世代、次々世代向けに取り組んでいる注力技術の一例をスライドに示しております。

これらの事業機会を着実に捉えるため、積極的に研究開発投資をおこない、将来の企業価値向上につなげてまいります。

FY2026 業績予想

次に、「FY2026の 業績予想」について 説明致します。

FY2026 業績予想

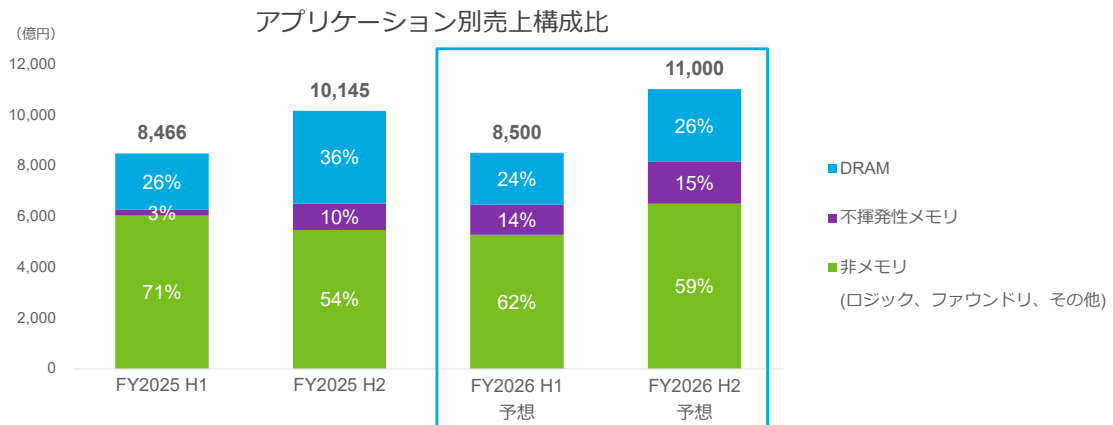
(億円)

	FY2025 (実績)	FY2026 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 YoY
売上高	24,315	11,500	14,500	26,000	+6.9%
売上総利益	11,462	5,270	7,010	12,280	+7.1%
売上総利益率	47.1%	45.8%	48.3%	47.2%	+0.1pts
販管費	4,489	2,390	2,620	5,010	+11.6%
研究開発費	2,500	1,400	1,600	3,000	+20.0%
研究開発費以外の販管費	1,989	990	1,020	2,010	+1.1%
営業利益	6,973	2,880	4,390	7,270	+4.3%
営業利益率	28.7%	25.0%	30.3%	28.0%	-0.7pts
税金等調整前当期純利益	7,061	2,930	4,430	7,360	+4.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	5,441	2,240	3,420	5,660	+4.0%
1株当たり当期純利益 (円)	1,182.40	488.97	-	1,235.51	+53.11

FY2026も過去最高の売上および営業利益を見込む。
将来の成長機会を最大限取り込むため、3,000億円の研究開発投資を計画

今期FY2026の、通期売上高は 2兆6,000億円、前期から、プラス 6.9%の成長を見込んでいます。詳細は御覧の表のとおりですが、今期も、過去最高の売上高、および 営業利益を見込んでいます。成長投資の手は緩めず、3,000億円の研究開発投資を計画しています。

FY2026 SPE新規装置売上予想



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

**CY2026の市場成長に向け、FY2026下期から各社準備を開始すると期待。
FY2026下期は過去最高の半期売上を予想**

次に、SPE 新規装置の 売上予想です。

前期FY2025の下期に、AIサーバー向け先端投資の前倒しや中国の前倒しがあった影響で、今期FY2026の上期は一服感が見られますが、下期には状況が改善し、来年CY2026の市場成長に向けた顧客の投資の動きが活発化すると予想しています。それを受け、今下期の新規装置の売上は、半期で過去最高の、1兆1,000億円となる見込みです。

FY2026 研究開発費・設備投資計画



宮城県黒川郡
2025年4月 竣工



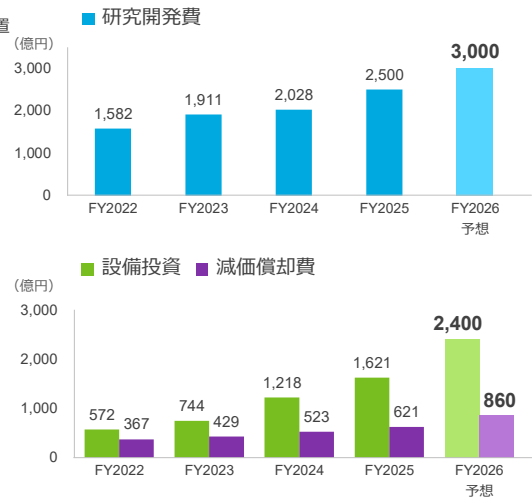
熊本県合志市
2025年秋 竣工予定



岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定



宮城県黒川郡
2027年夏 竣工予定

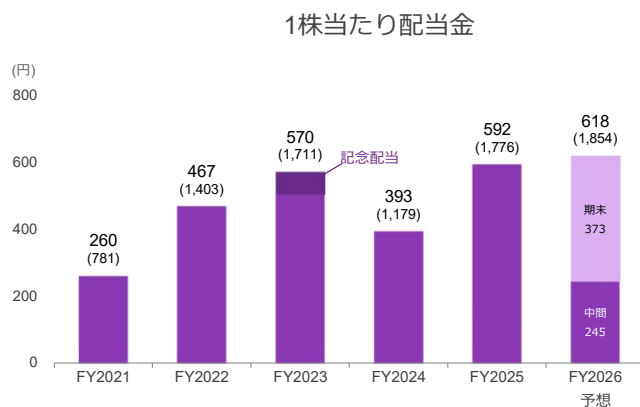


さらなる成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

次に、「研究開発費と設備投資の計画」です。

先日、竣工しました宮城の新開発棟を皮切りに、今期は、熊本の新開発棟、岩手の生産・物流センターが竣工予定です。また、次世代のスマートマニュファクチャリング構想を採り入れた、宮城の生産新棟も6月より着工します。FY2026の研究開発費は、3,000億円、設備投資、減価償却費は、それぞれ、2,400億円、860億円を見込んでおります。

FY2026 配当予想



- FY2021～2023の1株当たり配当額は、FY2021の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

2023年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は618円を予定

最後に、「配当予想」についてです。

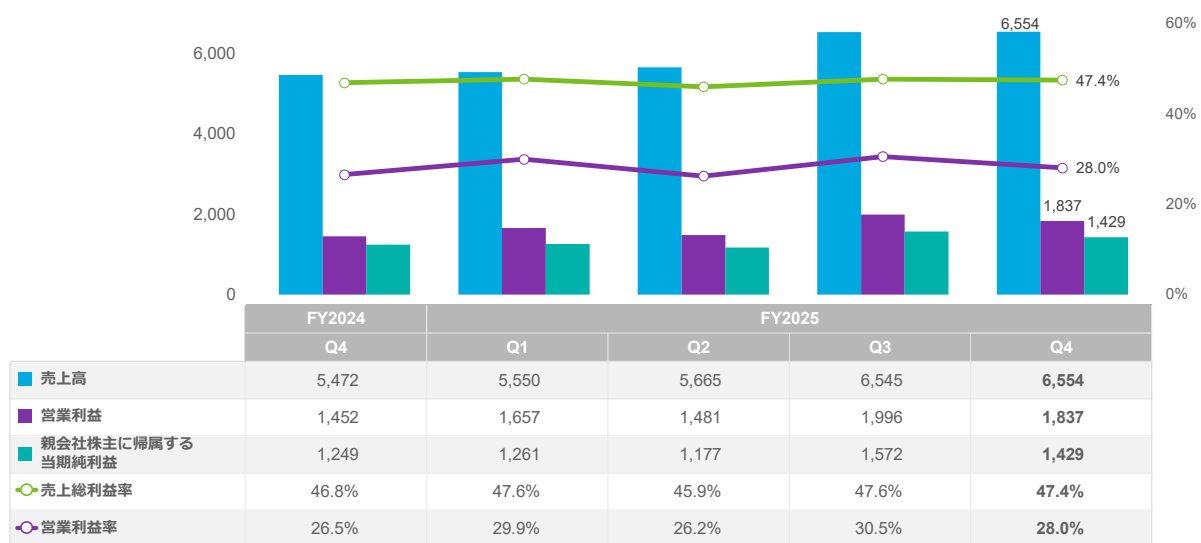
今期の1株当たりの配当は、こちらも過去最高の、通期 618円 を予定しております。

私からのご説明は以上です。ご静聴ありがとうございました。

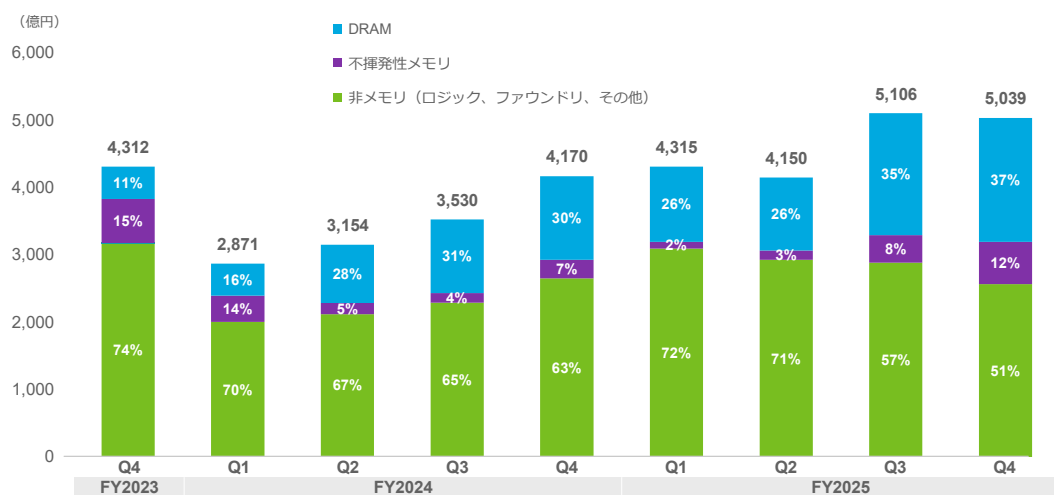
補足資料

損益状況（四半期）

(億円)



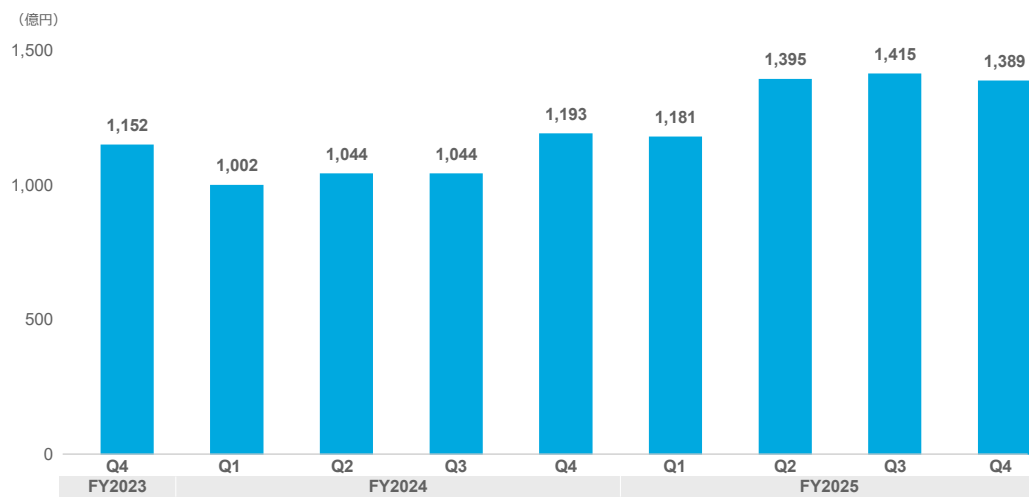
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



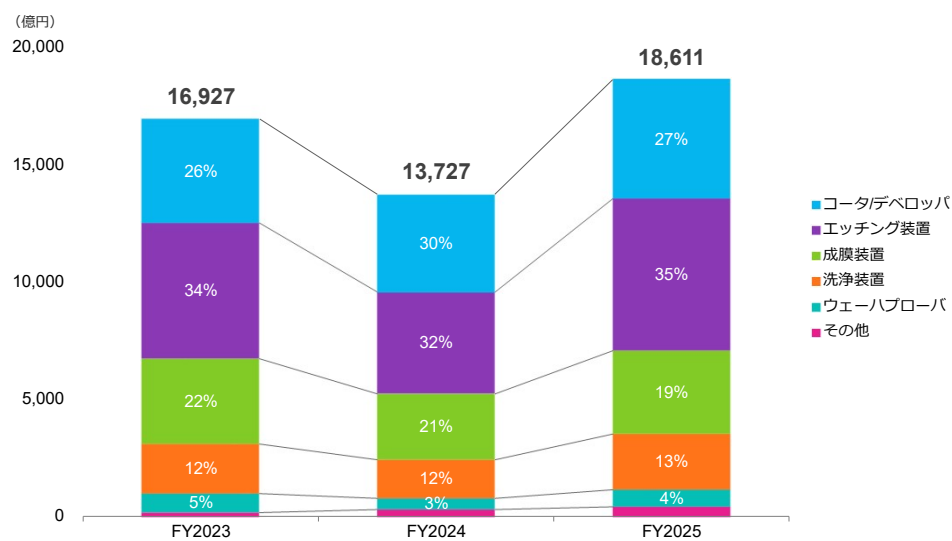
1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置

2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

フィールドソリューション売上高（四半期）

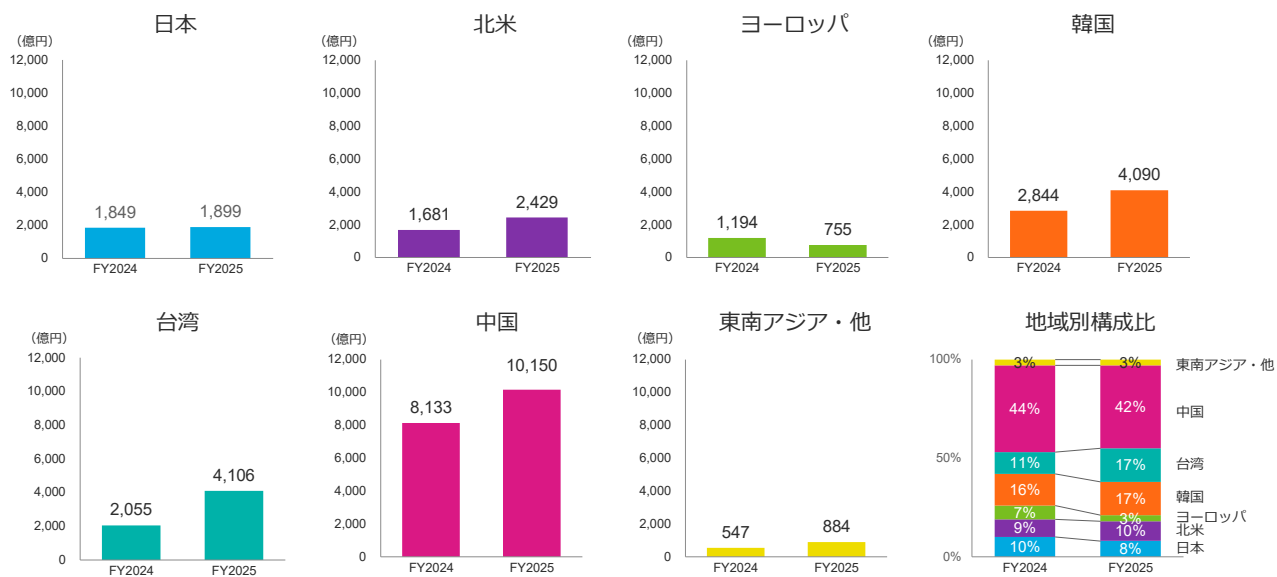


SPE新規装置 製品別売上構成比

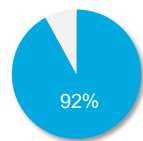


グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません

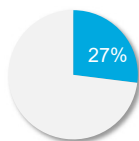
地域別売上高



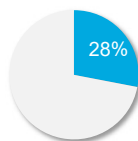
主要プロダクト 世界市場シェア（CY2024）



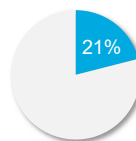
コータ/デベロッパ



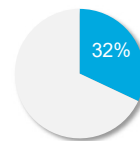
ドライエッチング装置



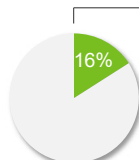
成膜装置



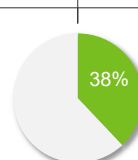
洗浄装置



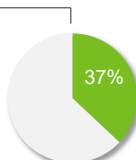
ウェーハボンダー



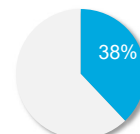
ALD



CVD



酸化/拡散



ウェーハプローバ

出所

Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson and Menglin Cao, 21 April 2025, Revenue from Shipments basis.

チャートはGartnerリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。ここに記載のある数値は、東京エレクトロンにより算出されたものです。

コータ/デベロッパ (Photoresist Processing (Track), ドライエッチング装置: Dry Etch, 成膜装置: Tube CVD + Atomic Layer Deposition Tools + Oxidation/ Diffusion Furnaces + Nontube LPCVD, ALD: Atomic Layer Deposition Tools,

CVD: Tube CVD + Nontube LPCVD, 酸化/拡散: Oxidation/Diffusion Furnaces, 洗浄装置: Single Wafer Processors + Wet Stations + Batch Spray Processors + Scrubbers + Other Clean Equipment, ウェーハボンダー: Wafer Bonder

GARTNERは、Gartner Inc. または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。 All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特

定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジユーザーに勧告するものではありません。 Gartnerリサーチの発

行物は、Gartnerリサーチの見解を示したものであり、事実を表現したものではありません。 Gartnerは、明示または暗示を問わず、本リサーチの商品性や特定の用途への適合性を認め、一切の責任を負うものではありません。

本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシグネチャ・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであ

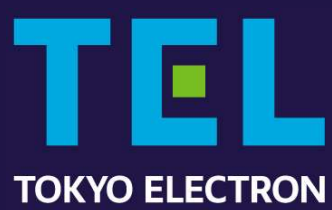
り、事実を述べているものではありません。 Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予

告なく変更されることがあります。

出所

半導体製造装置 (ウェーハプローバ) : Auto Probers: Technisights Inc., April 2025

図はTechnisights Inc.に基づき、東京エレクトロンが作成。



本資料の取扱い上の注意

当社の書面による承諾なしに複写、または
第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

 および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。